

ISPIT IZ OSNOVA ELEKTRONIKE

09.07.2015.

ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

ODSEK ZA SIGNALE I SISTEME

ODSEK ZA FIZIČKU ELEKTRONIKU

1. U kolu pojačavača sa slike 1, upotrebljeni su tranzistori sa $\beta_F = \beta_0 = 100$, $V_A \rightarrow \infty$, $V_t = kT/q = 25\text{mV}$, $|V_{BE}| = 0,6\text{V}$ i $|V_{CES}| = 0,2\text{V}$, a poznato je i $V_{CC} = -V_{EE} = 5\text{V}$. Odrediti:

- a) [3] otpornosti nepoznatih otpornika tako da u mirnoj radnoj tački bude $I_{C2} = I_{C3} = 1\text{mA}$ i $V_I = 0\text{V}$;
- b) [3] naponsko pojačanje pojačavača $a = v_i / v_u$;
- c) [2] ulaznu otpornost i izlaznu otpornost pojačavača;
- d) [2] maksimalnu amplitudu simetričnog neizobličenog napona na izlazu.

2. a) [5] Nacrtati diferencijalni pojačavač sa PMOSFET tranzistorima na ulazu, strujnim ogledalom sa odgovarajućim MOSFET tranzistorima za svođenje na jednostruki izlaz i strujnim izvorom sa odgovarajućim MOSFET tranzistorima za zadavanje struja polarizacije ulaznih tranzistora.

b) [2] Izračunati faktor potiskivanja signala srednje vrednosti za pojačavač iz tačke a).

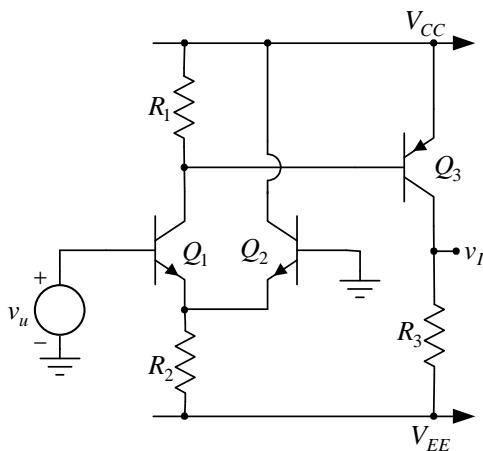
c) [3] Pojačavaču u tački a) treba dodati pojačavački stepen sa bipolarnim tranzistorom radi smanjenja izlazne impedanse i izračunati izlaznu impedansu modifikovanog pojačavača.

3. a) [3] Nacrtati simetrični pojačavač snage u klasi AB sa transformatorskom spregom na ulazu i izlazu, sa dva Darlingtonova para tranzistora, napravljena u kombinaciji NMOSFET na ulazu i NPN tranzistor na izlazu svakog para.

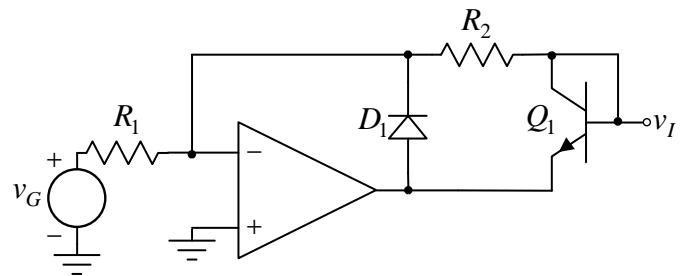
b) [3] Na istom dijagramu nacrtati radnu tačku, statičku (jednosmernu) i dinamičku (naizmeničnu) radnu pravu jednog od dva Darlingtonova para tranzistora iz pojačavača iz tačke a).

c) [4] Nacrtati vremenske dijagrame napona na krajevima oba Darlingtonova para tranzistora, izlaznih struja oba Darlingtonova para tranzistora i napona na potrošaču za pojačavač iz tačke a) sa sinusoidalnom pobudom.

4. [10] Operacioni pojačavač u kolu sa slike 4 je idealan i napaja se iz dve baterije za napajanje $V_{CC} = -V_{EE} = 15\text{V}$. Parametri bipolarnog tranzistora su: $V_{BE} = V_{BES} = V_\gamma = 0,6\text{V}$, $V_{CES} = 0,2\text{V}$ i $\beta_F \gg 1$. Dioda je idealna sa $V_D = 0,6\text{V}$, a poznato je i $R_1 = 5\text{k}\Omega$ i $R_2 = 25\text{k}\Omega$. Odrediti i nacrtati karakteristiku $v_I = v_I(v_G)$, ako se ulazni napon v_G menja u granicama $-5\text{V} \leq v_G \leq 5\text{V}$.



Slika 1



Slika 4

Studenti koji polažu drugi kolokvijum rade zadatke 3 i 4 u trajanju do 2 sata.

Studenti koji polažu kompletan ispit rade sve zadatke u trajanju do 3 sata.